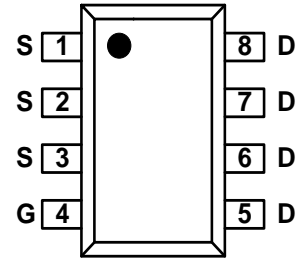




一、特点

- 12V 高密度设计的 P 沟道 MOS 管
- 超低导通电阻
- $R_{DS(ON)}=50m\Omega$, TYP@ $V_{GS}=-4.5V$
- $R_{DS(ON)}=68m\Omega$, TYP@ $V_{GS}=-2.5V$



二、产品应用

- 笔记本电脑的电源管理、便携式设备和电池供电系统

SOP-8

三、电特性

- 极限参数 ($T_A=25^\circ C$, 除其它特殊说明)

符号	参数	额定值	单位
V_{DSS}	漏源极电压	-12	V
V_{GSS}	栅源极电压	± 8	V
I_D	连续漏电流	-4.5	A
I_{DM}	脉冲漏电流	-15	A
I_S	二极管连续正向电流	-1	A
T_J	最高结温	150	$^\circ C$
T_{STG}	贮存温度	-55~150	$^\circ C$

- 静态电特性 ($T_A=25^\circ C$, 除其它特殊说明)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
BV_{DSS}	漏源极击穿电压	$V_{GS}=0V, I_{DS}=250\mu A$		-12		V
I_{DSS}	漏极电压漏电流	$V_{DS}=-12V, V_{GS}=0V$			1	μA
		$T_A=85^\circ C$			10	μA
$V_{GS(th)}$	门阈值电压	$V_{DS}=V_{GS}, I_{DS}=250\mu A$	-0.5	-0.7	-1.4	V
I_{GSS}	栅极漏电流	$V_{GS}=\pm 8V, V_{DS}=0V$			± 100	nA
$R_{DS(ON)}$	漏源极导通电阻	$V_{GS}=-1.8V, I_{DS}=-1A$		110	120	$m\Omega$
		$V_{GS}=-2.5V, I_{DS}=-3.5A$		68	78	$m\Omega$
		$V_{GS}=-4.5V, I_{DS}=-4.5A$		50	62	$m\Omega$
V_{SD}	二极管正向电压	$I_{SD}=-1A, V_{GS}=0V$			-1.3	V
R_G	栅极输入电阻	$V_{GS}=0V; V_{DS}=0V$ Frequency=1MHZ		6		Ω